

Министерство образования и науки Украины  
Национальная академия наук Украины  
Харьковский национальный университет радиоэлектроники  
Институт радиополупроводников им. А.Я. Усикова НАНУ  
Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАНУ  
Институт физики НАНУ  
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина  
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова

**IX МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
"Функциональная база нанoeлектроники"**

18 - 23 сентября 2017 г., г. Одесса, Украина

**Уважаемые коллеги!**

Приглашаем Вас принять участие в работе IX Международной научной конференции "Функциональная база нанoeлектроники", которая состоится в г. Одесса 18 - 23 сентября 2017 года.

Для участия в конференции приглашаются: ученые, эксперты, специалисты, аспиранты, студенты, представители предприятий всех форм собственности, учебных заведений Украины и зарубежья.

**НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:**

- новые фундаментальные положения теории и технологии формирования элементов нанoeлектроники;
- наноматериалы и структуры нанoeлектронной элементной базы;
- метаматериалы для нанoeлектроники
- сканирующие зондовые методы диагностики и технологии в нанoeлектронике;
- нанoeлектронные сенсоры физических величин;
- нанобиологические структуры;
- нанoeлектроника в микросистемной технике;
- фотоника на основе наноразмерных структур;
- гетероструктуры в нанoeлектронике;
- элементы функциональной нанoeлектроники;
- самоорганизующиеся структуры для нанoeлектроники;
- нанопечать, микро- и нанороботы;
- источники и приемники излучения на основе нанотехнологий;
- моделирование в нанoeлектронике.
- электродинамика и нанoeлектроника ТГц и ГГц диапазонов;
- метаматериалы и их применение в нанoeлектронике ТГц и ГГц диапазонов.

**Организационный взнос** для публикации материалов конференции:

для участников из Украины – **350 грн.**

для участников из стран СНГ - **25 Евро;**

для участников из дальнего зарубежья – **50 Евро.**

Оргвзнос включает в себя издание программы, сборника научных трудов конференции, а также затраты, связанные с покрытием расходов на

организацию и проведение конференции, в том числе расходы на рекламу, связь, кофе-брейк и др.

О принятии Оргкомитетом докладов и о банковских реквизитах для перечисления денег Вы будете уведомлены до 30 августа 2017 г. во втором информационном письме.

**ВАЖНЫЕ ДАТЫ:**

Подача материалов для опубликования	15.08.2017
Уведомление о принятии материалов	30.08.2017
Регистрация, открытие конференции.	18.09.2017

**ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ**

необходимо предоставить:

- Заявку (Приложение 1).
- Электронную версию доклада (E-mail: [imd@nure.ua](mailto:imd@nure.ua)) на одном из рабочих языков (английский, украинский, русский), оформленного в соответствии с требованиями к оформлению доклада и прилагаемым образцом (Приложение 2).
- Акт экспертной оценки (для сотрудников ХНУРЭ)

**ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА:**

- Объем – от 2-х до 4-х **полных** страницы формата **A4**, набранного в текстовом редакторе Microsoft Word.
- Поля – **30 мм**; абзацный отступ **1 см**.
- Гарнитура: Times New Roman, размер шрифта 11, интервал между строк – одинарный.
- Аннотация на английском языке (10-15 строк).
- Текст рукописи должен быть структурирован и содержать все *основные части, характерные для описания научного исследования*: **введение** (отражает *актуальность*, формулирование *цели и задач* исследования); **сущность** (изложение основного материала исследования с описанием идеи, метода и обоснованием полученных научных результатов); **выводы** (отражают результаты исследования, их *научную новизну* и

*практическую значимость*, сравнение с мировыми аналогами, перспективы); обязателен **список литературы** (до 5 источников).

- Формулы, символы, переменные, встречающиеся в тексте, должны быть набраны как объекты Microsoft Equation.
- Рисунки и таблицы должны быть четкими, компактными. Редакторы: CorelDraw, Table Editor, Microsoft Excel.
- Тексты докладов печатаются в авторском варианте без редактирования.

#### **Порядок размещения материала:**

**НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА** (большими буквами, жирно, по центру строки).

Следующей строкой – фамилии, инициалы авторов по центру строки.

Следующей строкой – полное название организации по центру строки.

Следующей строкой – почтовый адрес, телефон, E-mail организации или авторов.

Следующей строкой – аннотация на английском языке (10-15 строк).

Через строку – с абзаца печатать текст доклада.

#### **Приложение 1**

##### **Форма заявки:**

- Фамилия, имя, отчество авторов (полностью), ученое звание, научная степень, должность.
- Полное название организации.
- Адрес для переписки с указанием индекса города, факс, контактный телефон (с указанием кода),
- E-mail.
- Наименование научного направления.
- Форма участия (с докладом, без доклада)

#### **Приложение 2**

##### **ОБРАЗЕЦ**

##### **СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛОЗАМЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ**

Иванов И.И., Сергеев Н.А.

Харьковский национальный университет  
радиоэлектроники

61166, Харьков, пр. Науки, каф. системотехники,

тел. (057) 702-13-06, факс (057) 702-11-13

E-mail: [ivanov@kture.kharkov.ua](mailto:ivanov@kture.kharkov.ua);

The given work is devoted to the modern developments in the field of microwave devices used measuring etc. ... (10-15 строк).

Текст доклада ...

#### **АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:**

61166, г. Харьков, просп. Науки, 14, ХНУРЭ, ИМО (комн. 437) К.т.:(057)702-13-97; Ф.: (057) 702-13-97; E-mail: imd@nure.ua

#### **ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ**

##### ***Сопредседатели:***

проф. Лепих Я.И., проф. Слипченко Н.И.,  
проф. Тарапов С.И.

##### ***Члены программного комитета:***

Беляев А.Е. – член-корр. НАН Украины, проф., директор Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, г. Киев, Украина

Бондаренко И.Н. – проф., зав. каф. ХНУРЭ, г. Харьков, Украина

Вербицкий В.Г. – проф. НТУУ «КПИ», г. Киев, Украина

Гордиенко Ю.Е. – проф. ХНУРЭ, г. Харьков, Украина

Готра З.Ю. – проф., зав. каф. НТУ «Львовская политехника», г. Львов, Украина

Гринев Б.В. – академик НАН Украины, проф., зав. каф. ХНУ им. В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина

Зависляк И.В. – проф. Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, г. Киев, Украина

Катрич В.А. - д.ф.-м.н., проф., проректор по научной работе ХНУ им. В.Н.Каразина, г. Харьков, Украина

Костылев В.П. – нач. лаб. Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, г. Киев, Украина

Осипов А.Н. - проф., проректор по научной работе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, г. Минск, Беларусь

Негрійко А.М. – член-корр. НАНУ, зам. директора Института физики НАН Украины, г. Киев, Украина

Плаксин С.В. - д.ф.-м.н., с.н.с., зав. отделом Института транспортных систем и технологий НАН Украины, г. Днепр., Украина

Просвирнин С. Л. – проф. Радиоастрономического института НАН Украины, г. Харьков, Украина

Сизов Ф.Ф. – член-корр. НАН Украины, проф. Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, г. Киев, Украина

Скрышевский В.А. – проф., зав. каф. Института высоких технологий Киевского национального университета им.Т.Г.Шевченко, г. Киев, Украина

Chichkov B.N. - Prof., Dr., Head of the Nanotechnology Department Laser Zentrum, Hannover, Germany

Якименко Ю.И. – академик НАН Украины, проф., первый проректор НТУУ «КПИ», г. Киев, Украина

Ямпольский В.А. – член-корр. НАН Украины, проф. ИРЭ им. А.Я. Усикова НАН Украины, г. Харьков, Украина